

# تولید نور غیر کلاسیک از نقطه‌های کوانتومی

## Generation of Non-Classical Light from Quantum Dots

مسعود شاه‌مرادی - رسول رکنی‌زاده

گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی - دانشگاه اصفهان

چکیده: در این مقاله نشان داده‌ایم که می‌توان از حصر کولنی در نیمه‌رساناهایی با پیوند ناممکن برای ایجاد همبستگی بین تونل زنی تک بار و گسیل تک فوتون استفاده کرد. در این‌گونه ساختارها انرژی تزریق تک الکترون باید بیشتر از پهنای زیر بانده تشدید و انرژی مشخصه افت و خیزهای گرمایی باشد تا این اثرات مشاهده شود.

با توجه به رشد رایانه‌های کوانتومی و فناوری مخابرات راه دور، نیاز به توسعه منابع نور غیر کلاسیک بیش از پیش احساس می‌شود. نیاز به انتقال داده‌ها با نرخ بالاتر فناوری‌های حاضر را به زودی به حدی می‌رساند که یک بیت اطلاعات را فقط چند فوتون حمل می‌کنند و این هم‌رتبه با نوفه کوانتومی ذاتی برای منابع نور کلاسیک است. به همین منظور تولید و آماده‌سازی و بررسی رفتار نورهای غیر کلاسیک امروزه حجم عمده‌ای از پژوهش‌ها را به خود اختصاص داده است. برای نورهای غیر کلاسیک تابع **همدوسی مرتبه دوم** [۱] برای تأخیر زمانی صفر می‌تواند در بازه زیر قرار بگیرد

$$1 \geq g^2(0) \geq 0 \quad (1)$$

در حالی که در موارد کاملاً کلاسیکی فقط  $g^2(0) \geq 1$  است و حالت‌هایی از میدان که  $g^2(0)$  آن‌ها بین صفر و یک باشد را حالت‌های غیر کلاسیک می‌نامیم که مانسته‌ی کلاسیک ندارد.

برای تولید نورهای غیر کلاسیک عمدتاً از ساختارهای ماده چگال استفاده می‌شود. به ویژه این که کنترل رشد و تولید نانوساختارهای نیم‌رسانا (نقطه‌های کوانتومی) به صورت اتم‌های مصنوعی امکان تولید حالت‌های کوانتومی و به خصوص تک فوتون را فراهم نموده‌اند.

در یک پیوندگاه  $p-i-n$  رژیم «حصر کولنی» عبارت است از بازه پارامتری که در آن انرژی تونل زنی تک الکترون  $(e^2/C_d)$  (که در اینجا ظرفیت پیوندگاه است) از سایر انرژی‌های مشخصه سیستم بیشتر می‌شود. به طور مثال این انرژی در این رژیم باید از انرژی مشخصه افت و خیزهای گرمایی  $(kT)$  و یا پهن شدگی انرژی فرآیند تونل‌زنی خود الکترون  $(\Gamma_e)$  بیشتر شود. وابستگی تابعی انرژی پیوند به ولتاژ

پیوند  $E = 1/2C_d V_j^2$  است که  $V_j$  ولتاژ پیوندگاه است. برای  $V_j = 0$ ، رویداد تونل‌زنی نمی‌تواند رخ دهد. از طرف دیگر چون تغییرات انرژی در نتیجه تونل‌زنی برابر  $\Delta E = e^2/C_d$  است و این انرژی را در رژیم حصر کولنی نمی‌توان با هیچ منبع دیگری فراهم کرد از این‌رو فقط وقتی که  $V_j$  بزرگتر از  $e^2/(2C_d)$  است، ما انتظار دیدن رویداد تونل‌زنی را

داریم. اما به دنبال اولین تونل زنی، رویداد تونل‌زنی دوم برای پنجره زمانی  $\tau = e/I$ ، ممنوع خواهد بود، در نتیجه تک الکترون در هر بازه زمانی منظم  $\tau$  تزریق می‌شود. این امر باعث همبستگی بین رویدادهای تزریق الکترون پی‌درپی می‌شود. اما به دلیل مشکلات آزمایشگاهی [۲] اثر حصر کولنی در پیوندگاه‌هایی با یک سد قابل

مشاهده نیست و به همین منظور از ساختارهایی چون  $p-i_p-i_n-n$  (GaAs-AlGaAs) استفاده می‌شود. از آنجایی که ما به دنبال آمار زیرپوآسونی برای تزریق الکترون‌ها هستیم (که نتیجه آن تولید فوتون‌هایی با آمار زیر پوآسونی است) نیاز به پیوندگاه‌هایی با

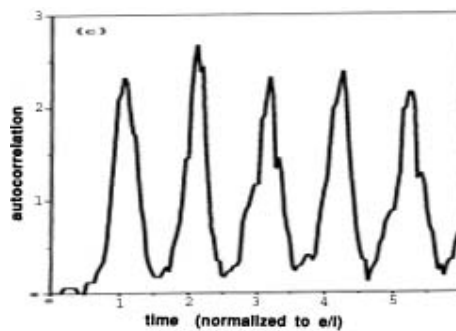
سطح مؤثر بسیار کوچک داریم [۳]. اگر ولتاژ پیوندگاه  $V_j(t)$  به مقدار کافی زیر پتانسیل ساختاری (built-in) باشد ( $V_{bi} - V_j(t) \gg kT$ )، انتقال حاملها در چنین ساختاری توسط تونلزنی الکترونها و حفرهها از نواحی نیالوده لایه‌های سدی  $i_p$  و  $i_n$  AlGaAs، رخ می‌دهد و الکترون و حفره تزریق شده به صورت تابشی در لایه i-GaAs ترکیب می‌شوند. فرض می‌کنیم عرض چاه کوانتومی i-GaAs به اندازه ای کوچک باشد (از مرتبه ده آنگستروم) که جداشدگی باندهای انرژی چاه کوانتومی به اندازه کافی از انرژی تزریق الکترون (حفره) به درون جزیره کولبی GaAs بیشتر باشد، آنگاه در تونلزنی تشدیدي فقط يك زیر نوار رسانش (ظرفیت) شرکت می‌نماید. تونلزنی تشدیدي يك الکترون و یا حفره تنها وقتی که ولتاژ پیوندگاه به فرم زیر باشد مجاز است:

$$E_{fh} - \frac{e^2}{2C_{ni}} \geq E_{res,e} \geq E_{nc} - \frac{e^2}{2C_{ni}} \quad \text{الکترونها} \quad (2)$$

$$E_{fp} + \frac{e^2}{2C_{pi}} \leq E_{res,h} \leq E_{pv} + \frac{e^2}{2C_{pi}} \quad \text{حفرهها} \quad (3)$$

در این جا  $E_{res,e}$  ( $E_{res,h}$ ) انرژی زیر نوار تشدیدي الکترون (حفره) در چاه کوانتومی GaAs،  $E_{nc}$  و  $E_{pv}$  انرژی باند های رسانش و ظرفیت در لایه‌های  $n$  و  $p$ ،  $E_{fn}$  و  $E_{fp}$  انرژی های شبه فرمی در لایه‌های مربوطه و  $C_{ni}$ ،  $C_{pi}$  ظرفیت ناحیه‌های  $n-i$  و  $p-i$  هستند.

در چنین ساختاری در دمایی بسیار پایین در مد عملیاتی جریان ثابت، نوسان منظم ولتاژ پیوندگاه و جریان منظم تک فوتون تولید می‌شود و در مد عملیاتی ولتاژ ثابت اگر چه رویدادهای تونلزنی منفرد، خیلی منظم نیست لکن گسیل فوتونی و رویدادهای تونلزنی تشدیدي، قویاً همبسته هستند [۴]. در شکل (۱) نمودار خودهمبستگی برای مد عملیاتی جریان ثابت ارائه شده است همانطور که مشخص است فوتون‌های تولید شده در این مد پادگروهه و زیر پوآسونی هستند، خواصی که نمی‌توان توسط نظریه‌های نیمه‌کلاسیک آنها را توضیح داد.



شکل (۱)

منابع و مراجع:

- [1] R.Loudon, The Quantum Theory of light (oxford, 1983).
- [2] M.H.Devoret, D.Esteve, H.Grabert, G.L.Ingold, H.Pothier and C.Urbina, Phys. Rev. Lett. **64**, 1824 (1990).
- [3] A.Imamoghlu and Y.Yamamoto, Phys. Rev. Lett. **70**, 3327 (1993).
- [4] A.Imamoghlu and Y.Yamamoto, Phys. Rev. B. **46**, 15982 (1992).